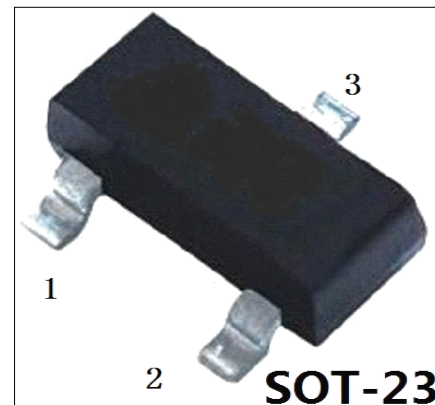


- ■ 主要用途：通用放大等。
Applications: general blow up。

- ■ 特性
Features

特性参数 CHARACTERISTIC	符号 SYMBOL	额定值 RATING	单位 UNIT
集电极-基极电压 Collector-Base Voltage	V_{CBO}	80	V
集电极-发射极电压 Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	80	V
发射极-基极电压 Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	4	V
集电极电流 Collector Current	I_C	500	mA
集电极耗散功率 Collector Power Dissipation	P_C	350	mW
结温 Junction Temperature	T_j	150	°C
储存温度 Storage Temperature	T_{stg}	-55~150	°C



- ■ 引脚说明

Pin assignment

PIN NAME 管脚符号	PIN NUMBER 引脚序号	FUNCTION 功能
	SOT-23	
B	1	BASE
E	2	EMITTER
C	3	COLLECTOR

- ■ 电参数

Electrical Characteristics($T_C = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

特性参数 CHARACTERISTIC	符号 SYMBOL	测试条件 TEST CONDITIONS	最小值 MIN.	典型值 TYP.	最大值 MAX.	单位 UNIT
集电极-基极反向截止电流 Collector Cut-off Current	I_{CBO}	$V_{CB} = 80\text{V}, I_E = 0$			0.1	μA
发射极-基极反向截止电流 Emitter Cut-off Current	I_{EBO}	$V_{EB} = 4\text{V}, I_C = 0$			0.1	μA
集电极-基极反向击穿电压 Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	$I_C = 0.1\text{mA}, I_E = 0$	80			V
集电极-发射极反向击穿电压 Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	$I_C = 1\text{mA}, I_B = 0$	80			V
发射极-基极反向击穿电压 Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = 0.1\text{mA}, I_C = 0$	4			V
直流电流增益 DC Current Gain	h_{FE1}	$V_{CE} = 1\text{V}, I_C = 10\text{mA}$	100			
	h_{FE2}	$V_{CE} = 1\text{V}, I_C = 100\text{mA}$	100			
集电极-发射极饱和压降	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 100\text{mA}, I_B = 10\text{mA}$			0.25	V

Collector-Emitter Saturation Voltage						
基极-发射极饱和压降 Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$	$V_{CE}=1V, I_C=100mA$			1.2	V
特征频率 Gain Bandwidth Product	f_T	$I_C=10mA, V_{CE}=2V, f=100MHz$	100			MHz

■ ■ 打标、分档

DEVICE MARKING

打标 Marking	FS
分档 Value	≥100

■ ■ 尺寸图

DIMENSION

